

# АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

## «ОСНОВЫ КРИСТАЛЛОГРАФИИ»

**22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»**

код направления подготовки

### **4 семестр**

- 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:** формирование инженерных знаний и навыков в области кристаллографии.
- 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:** Учебная дисциплина «Основы кристаллографии» относится к вариативной части блока 1 ОПОП ВО.
- 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:**
  - ОПК-5 «Способность применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды»;
  - ПК-6 «Способность использовать на практике современные представления о влиянии микро- и нано- структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, полями, частицами и излучениями»;
  - ПК-11 «Способность применять знания об основных типах современных неорганических и органических материалов, принципах выбора материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности, экологических последствий их применения при проектировании высокотехнологичных процессов»

### **4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:**

ВВЕДЕНИЕ. Кристаллография как наука. История развития кристаллографии. Разделы кристаллографии.

Тема 1. Основные понятия о кристаллах.

Тема 1.1. Понятие о кристалле, элементы кристалла. Пространственная решетка, особенности её строения.

Тема 1.2. Основные свойства кристаллических веществ: однородность, анизотропность, способность самоограняться, постоянная точка плавления.

Тема 1.3. Пути образования кристаллов: кристаллизация из расплавов; кристаллизация из растворов; кристаллизация из газообразного состояния (возгонка); кристаллизация из твердого состояния.

Тема 1.4. Явления, сопровождающие кристаллизацию. Дендритный рост кристаллов.

Тема 2. Геометрическая кристаллография.

Тема 2.1. Законы кристаллографии. Закон постоянства граничных углов. Закон рациональных двойных отношений, или закон целых чисел (закон Аюи).

Тема 2.2. Симметрия кристаллов. Элементы симметрии. Понятие о сингониях.

Тема 2.3. Формы кристаллов. Простые формы. Комбинации простых форм. Формы реальных кристаллических многогранников.

Тема 2.4. Рентгеновские лучи и структура кристаллов. Методы мерентгеноструктурного и рентгенофазового анализа.

Тема 3. Основы кристаллохимии.

Тема 3.1. Взаимодействие частиц в кристалле.

Тема 3.2. Типы химических связей. Молекулярные кристаллы. Ковалентные кристаллы. Металлические кристаллы. Ионные кристаллы.

Тема 3.3. Плотнейшие шаровые упаковки. Индексы Миллера

Тема 3.4. Способы изображения структур минералов: способ изображения структур шарами; способ изображения структур путем нанесения центров тяжести шаров; способ изображения структур координационными полиэдрами (формой группировок катионов и анионов). Мотивы структур: координационный мотив структуры; островной мотив структуры; цепочечный и ленточный мотивы структуры; слоистый мотив структуры; каркасный мотив структуры.

Тема 3.5. Изоморфизм. Условия, необходимые для проявления изоморфизма. Типы изоморфизма.

Тема 3.6. Полиморфизм.

Тема 4. Основные понятия из физической кристаллографии.

Тема 4.1. Твердость кристаллов. Эталоны шкалы Мооса.

Тема 4.2. Спайность.

Тема 4.3. Способность к пластической деформации.

Тема 4.4. Тепловые свойства кристаллов. Теплопроводность. Коэффициент линейного температурного расширения.

Тема 4.5. Электрические свойства кристаллов. Пьезоэлектрический эффект кристаллов. Явление пьезоэлектричества.

Тема 4.6. Оптические свойства кристаллов.

Тема 5. Введение в минералогию.

Тема 5.1. Морфология минералов. Морфология кристаллов. Морфология агрегатов.

Тема 5.2. Основные физические свойства.

## 5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – зачет с оценкой

## 6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 3 зач.ед.

Составитель: доцент кафедры ТФ и КМ

Картонова Л.В.

Заведующий кафедрой ТФ и КМ

Кечин В.А.

Председатель  
учебно-методической комиссии направления

Кечин В.А.

Декан МТФ

Елкин А.И.

Дата: 17.12.2015 г.

